

2SA1928

低雑音差動増幅用
シリコンPNPエピタキシャル形
デュアルトランジスタ

概要

2SA1928は、シリコンPNPエピタキシャル形デュアルトランジスタで低雑音差動増幅用として設計されたものです。特性の良く揃ったトランジスタ2個が樹脂封止の5ピン・シングルラインの小形外装に組み立てられているので、ステレオのプリアンプ、メインアンプ初段の低雑音差動増幅用、また、ベア特性が要求される回路等に最適です。

特長

- 耐圧が高い $V_{CE0}=-100V$
- 雑音指数、雑音電圧が小さい NF=0.5dB 標準 NV=100mV 標準
- ベア特性が良い

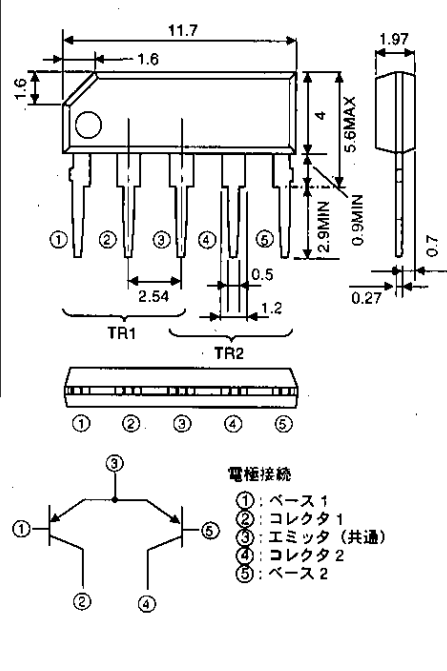
$h_{FE1}/h_{FE2}=0.98$ 標準
 $|V_{BE1}-V_{BE2}|=1mV$ 標準

- 直流電流増幅率が高い $h_{FE}=250\sim 800$

用途

低雑音・低レベル差動増幅、直流増幅用

外形図



最大定格 ($T_a=25^\circ C$)

記号	項目	定格値	単位
V_{CB0}	コレクタ・ベース間電圧	-100	V
V_{EB0}	エミッタ・ベース間電圧	-5	V
V_{CE0}	コレクタ・エミッタ間電圧	-100	V
I_C	コレクタ電流	-50	mA
P_C	コレクタ損失 ($T_a=25^\circ C$)	200	mW/unit
P_T	全損失 ($T_a=25^\circ C$)	400	mW
T_J	接合部温度	+125	$^\circ C$
T_{stg}	保存温度	-55~+125	$^\circ C$

電気的特性 ($T_a=25^\circ C$)

記号	項目	測定条件	特性値			単位
			最小	標準	最大	
$V_{(BR)CE0}$	コレクタ・エミッタ降伏電圧	$I_C=-100\mu A, R_{BE}=\infty$	-100			V
I_{CBO}	コレクタしゃ断電流	$V_{CB}=-70V, I_E=0mA$			-0.1	μA
I_{EBO}	エミッタしゃ断電流	$V_{EB}=-2V, I_C=0mA$			-0.1	μA
I_{CER}	コレクタしゃ断電流	$V_{CE}=-100V, R_{BE}=100k\Omega$			-10	μA
h_{FE}^*	直流電流増幅率	$V_{CE}=-6V, I_C=1mA$	250		800	—
$V_{CE(sat)}$	コレクタ・エミッタ飽和電圧	$I_C=-10mA, I_B=-1mA$			-0.6	V
$ V_{BE1}-V_{BE2} $	ベース・エミッタ電圧差	$V_{CE}=-6V, I_C=1mA$		1	10	mV
h_{FE1}/h_{FE2}	直流電流増幅率比 (注1)	$V_{CE}=-6V, I_C=1mA$	0.8	0.98	1.0	—
f_T	利得帯域幅積	$V_{CE}=-6V, I_E=1mA$		150		MHz
C_{ob}	コレクタ出力容量	$V_{CB}=-6V, I_E=0mA, f=1MHz$		2.5		pF
NF	雑音指数	$V_{CE}=-6V, I_E=0.1mA, f=1kHz, R_G=10k\Omega$		0.5		dB
NV	低周波広帯域雑音電圧	$V_{CE}=-10V, I_E=1mA, R_G=100k\Omega, G_v=80dB$, 測定回路図参照		100		mV
NV_M	雑音電圧			0.5		V

(注1) 2つの素子のうちで、 h_{FE} の低い方を h_{FE1} とする。

*: 素子1の h_{FE} の値により右表のようにアイテム分類を行っています。

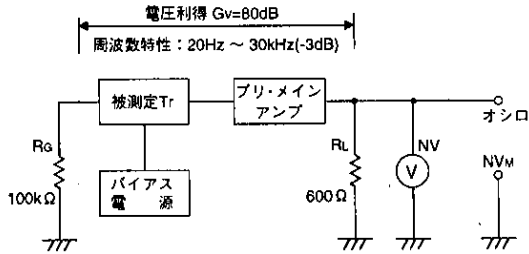
マーキング	F	G
h_{FE}	250~500	400~800

2SA1928

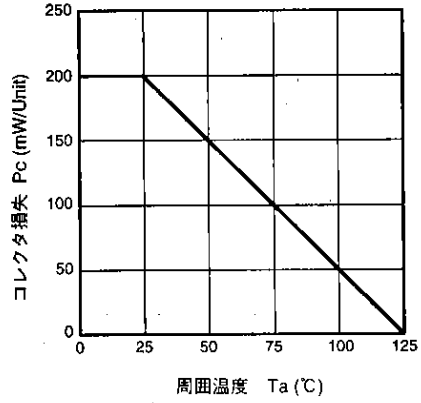
低雑音差動増幅用
シリコンPNPエピタキシャル形
デュアルトランジスタ

標準特性

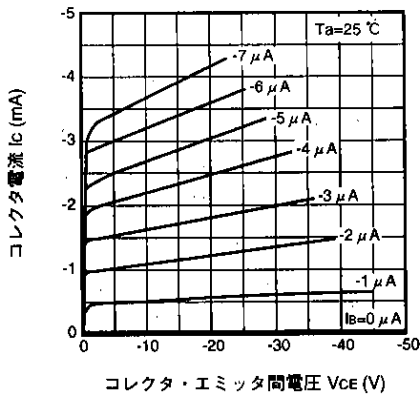
低周波広帯域雑音電圧測定回路



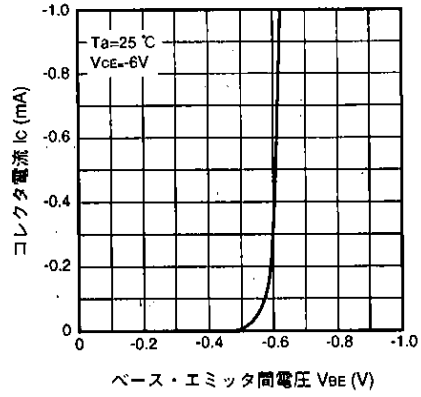
コレクタ損失-周囲温度特性



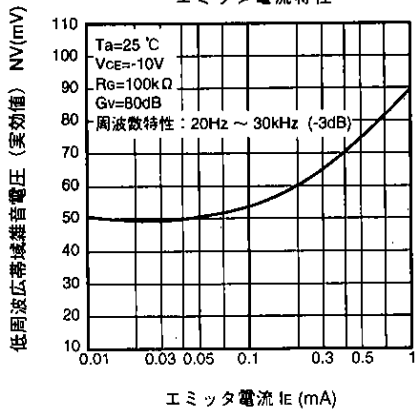
エミッタ接地出力特性



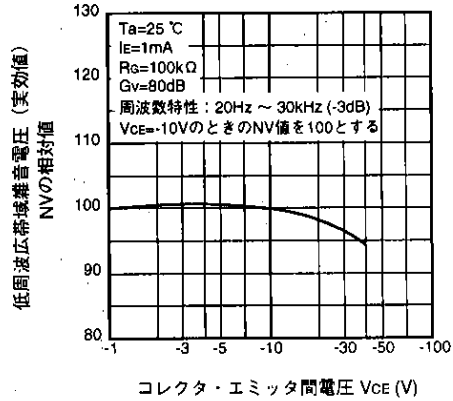
エミッタ接地伝達特性



低周波広帯域雑音電圧 (実効値) - エミッタ電流特性

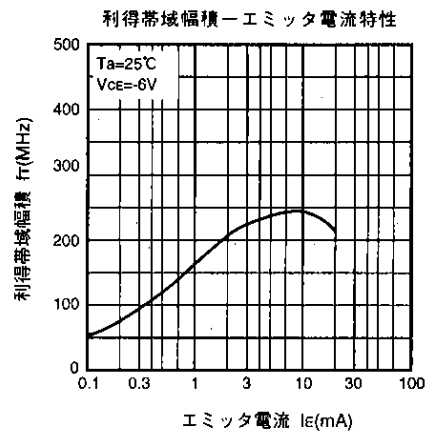
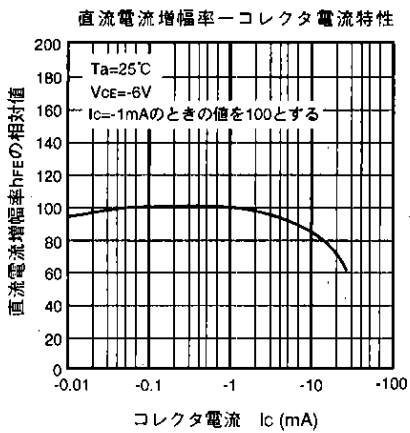
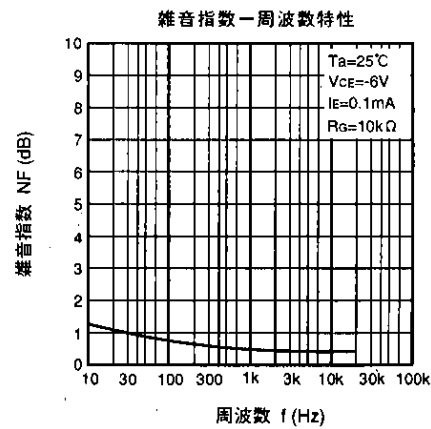
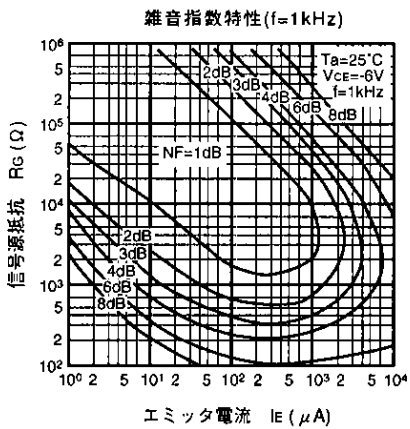
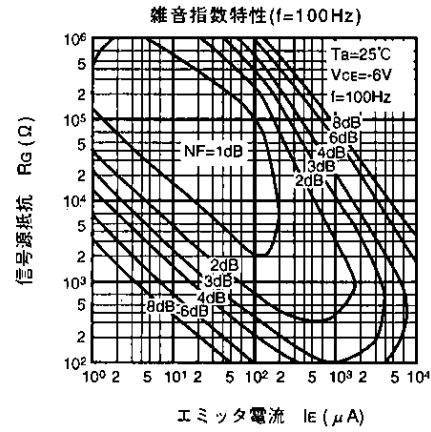
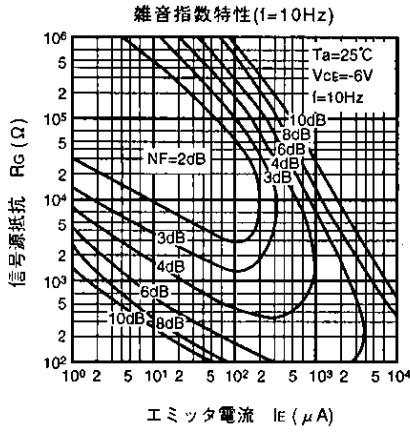


低周波広帯域雑音電圧 (実効値) - コレクタ・エミッタ間電圧特性



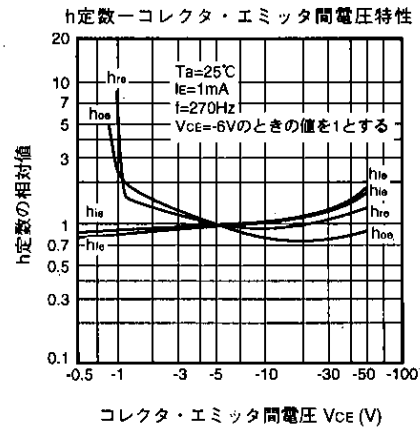
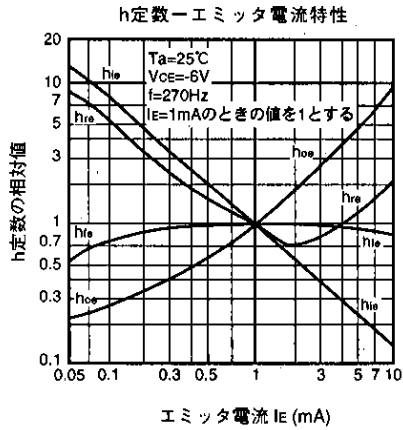
2SA1928

低雑音差動増幅用
シリコンPNPエビタキシャル形
デュアルトランジスタ



2SA1928

低雑音差動増幅用
シリコンPNPエビタキシャル形
デュアルトランジスタ



エミッタ接地h定数 (標準値)

記号	項目	測定条件	特性値	単位
h_{ie}	閉路小信号入力インピーダンス	$T_a=25^\circ\text{C}$ $V_{CE}=-6\text{V}$ $I_e=1\text{mA}$ $f=270\text{Hz}$	14	$\text{k}\Omega$
h_{re}	閉路小信号逆電圧増幅率		0.08	$\times 10^{-3}$
h_{fe}	閉路小信号順電流増幅率		500	—
h_{ce}	閉路小信号出力アドミタンス		19	μS

安全設計に関するお願い

- ・弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社製品の故障または誤動作によって、結果として人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご注意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

- ・本資料は、お客様が用途に応じた適切なイサハヤ電子製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてイサハヤ電子が所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表その他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、イサハヤ電子は責任を負いません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表その他全ての情報は、本資料発行時点のものであり、特性改良などにより予告なしに変更することがあります。製品の購入に当たっては、事前にイサハヤ電子へ最新の情報をご確認ください。
- ・本資料に記載された製品は、人命に関わるような状況の下で使用される機器、あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海中継機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、イサハヤ電子へ御照会ください。
- ・本資料の転載、複製については、文書によるイサハヤ電子の事前の承諾が必要です。
- ・本資料に関し詳細についてのお問合せ、その他お気付きの点がございましたら、イサハヤ電子まで御照会ください。